APANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62044571 A

(43) Date of publication of application: 26 . 02 . 87

(51) Int. CI

C23C 14/48

(21) Application number: 60182772

(22) Date of filing: 20 . 08 . 85

(71) Applicant:

TOSHIBA MACH CO LTD

(72) Inventor:

MUTO TEIICHI

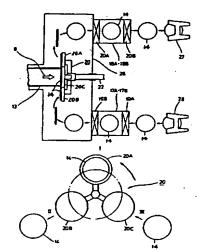
(54) ION IMPLANTATION DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To considerably reduce the time for treatment by executing the attachment and detachment of wafers in separate stations so that ion implantation is made possible even during the time when an index table is under rotation for indexing.

CONSTITUTION: A wafer 14 taken out of a cassette 28 enters a vacuum lock chamber 17A. After a pressure is regulated therein, the wafer 14 enters a chamber 26 and is attached to a platen 20C. The wafer 14 is then positioned to face a Faraday cup 13 by an indexing table 20 rotating to make indexing and is subjected to the ion implantation by the ion beam 8. The wafer is thereafter rotated 120° from the station I to the station II in the counterclockwise direction, where the wafer 14 is removed. The removed wafer is sent into a vacuum lock chamber 18A. The wafer 14 is housed from the chamber 18A into a cassette 27.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio



①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-44571

@int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)2月26日

C 23 C 14/48

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

の発明の名称 イオン注入装置

到特 題 昭60-182772到出 題 昭60(1985)8月20日

②発明者 武藤 禎一

沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内

印出 願 人 東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号

明 細 夢

1. 発明の名称
イオン氏入装置

2. 特許請求の範囲

イオン住入を行うチャンパ内にウェハの割り出し台とファラデーカップとウェハ搬送機構とを有しかつ前記ウェハの嵌入かよび搬出のための真空ロック室を前記チャンパに接して設けたイオン注入装位にかいて、

※ 等間隔に配置した3個のブラテンを有しこのブラテンを住入ステーション・ウエハ取り外しステーション・ウェハ取り付けステーションの3ステーションに対し順次割り出し回転する前記割り出し台と、前記テャンバに接してそれぞれ2類づつ設けた前配真空ロック室とを有するイオン住入装置。

2) ブラテンのウェハ収付適を、垂直・水平下向 き・垂直と水平下向きの中間、ならびに垂直に 近い上向きのいずれかにしたことを特徴とする - 特許請求の範囲第1項記載のイオン注入装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野) 本発明はイオン注入延復に関する。

〔従米技術〕

在来のイオン住入 医世の一例を第6図かよび第7図により述べる。イオン住入用のチャンパ11 内に10-6 To X r 程度の英空に保たれてかり、ことには割り出し台12とファラデーカッブ13と不図示のウェハ激送 既得等とが設けてある。割り出し台12はウェハ14を不図示のクランプ機構を介して固定する一対のブラデン15 かよび16を有し、これは軸とを中心として180°の割り出し回転が行われる。なか回転方向は一方向或いは正逆交互のいづれてもよい。

ファラデーカップ13は第7図において下倒のブラテン15に対し版間を有して対向しており、 これはイオン任人の嵌ウエハ14から飛放する2 次電子をウエハ14に戻すためのものでもって、 マイナス電圧が与えられており上配版間は可能な 限り小さい方がよい。またファラデーカップ13はブラテン15 尊が割り出し回転をするときこれと干部するのを避けるため回転をするときは一旦 後退(左進)し次いで図示の位置に戻る。なか図 にかいて大きな矢印8はイオンビームである。

テャンパー1にはウェハ14の搬入および搬出のための英型ロック盆17および18がこれに接して設けられてかり、各英型ロック盆17かよび18はそれぞれ一対のバルブ19A・19B・20A・20Bを有しかつ室内を真空引きするための配管(図示せず)と留内に乾燥な深を導入し大気圧まで高めるための配管(図示せず)とが優況されている。この真型ロック盆17かよび18に真空引きの時間を放小にするため容積は可能な限り小さくする。

成述した従来例の如作を述べる。カセット 2 8 から取り出されたウエハ1 4 は既に開かれているパルブ1 9 A を通って真空ロック室1 7 に入りこのときパルブ1 9 A を閉じ真空ロック室1 7 を真空引きし

圧化達すると、パルプ20Aを開いて次のウェハの導入を待つ。とれてし枚のウェハのイサン庄入は終了する。

(強明の目的)

本希明はこのような欠点を除去したものでその目的は、ブラテンに対するウェハの取りつけと取りはずしを別のステーションで行うことによりウェハの取りつけと取りはずしに要する時間を短縮しもってスルーブットを向上させたイオン在入茲

所定の真空に達すると、パルプ19Bを聞いてク エハ14をチャンパ11円に移卸しさらにブラテ ン16亿収置されてクランプされる。ウエハ14 がチャンパ11内に移動されると進ちにパルプ 19Bを閉じて真空ロック富17には乾燥盥索が 導入され、同宝17内が大気圧に達するとパルブ 19Aは開いて新しいウエハがカセット28から 送られる。ウエハ14を戦世したブラテン16は **仏軸を中心にして180° 期り出し回転を行い第7** 図のプラテン15の盤かれた下方位置でイオン庄 入を行い、イオン庄入が終了するとブラテン16 は再び180 割り出し回伝されて図示の上方位置 化戻る。このとき其空ロック室18は既に其空引 きされかつパルプ20人は聞いているためウエハ 14を同国18に移し、次いでパルブ20Aを閉 じた使同宝18に吃燥空氣を導入し大気圧にたっ たときパルプ20Bを開いて処理すみのウエハ 14をカセット27に送りこむ。ウエハ14を真 空ロック室18から取り出すと直ちにパルプ20 Bは閉ざされ同窒18の真空引きを行い所定真空

置を提供することにある。

[発明の要点]

本発明のイオン注入契値は、イオン注入を行うチャンパ内にウェハの割り出し台とファラデーカップとウェハ搬送機構とを有しかつウェハの搬入および搬出のための真空ロック室をチャンパに役して数けたイオン住入 延世にからのブラテンを可に配置した3個のブラテンを有している。カエハ取り付けステーションに対し順次割り出し回転することを特徴にしている。

[発明の突施例]

以下本発明の一実施例を示した第1図ないし第4図について説明する。第3図かよび第4図は割り出し台とファラデカップを示した図面であって、割り出し台20は一平面上120%に配置された3個のブラテン20A等は下面が腕21により互に連結され、かつ腕21は軸22.に固層されているため

また朝4図に歩いてウェハ14はイオン任人面に 版次等を付着させないようにし、 歩留りと品質を同上させるため、 経直面でブラテン 20 Aに取り付けるようになっているが、 その面を実下に向けてもよいし中間の角度でもよく。さらに 垂直に近ければ上向きでもよい。 ただし、 とのウェハ14 の位置に応じてイオンビームの入射方向が足められる。 第1図 シェび第2 図红全体的な配置を示し

ルブ19Bは閉ざされ其空ロック室17Aに遊像の 密素が導入されが開いて新しいかな工を取れておりれてのかな工が、 28から送られて第3図にかけて反映計が、 120°回転させるとかがですが、 120°回転させるとかがですが、 120°回転させるとかがですが、 120°回転させるとかがですが、 14な受けて、 14な受けて、 14な受けて、 14なで、 120°回転ではないでは、 120°回転が、 120°回が、 120°回が

次いでパルプ 2 0 A を閉じ同 室 1 8 A C 乾燥器 業を導入し、同 室 1 8 A Pの 気 E が 大 気 E に なる とパルプ 2 0 B を 開いて ウェハ 1 4 を カセット 2 7 に入れる。 4 望ロック 室 1 8 A . 1 8 B は 同 1 7 A . 1 7 B と 同様 に 交 互 に 使 用 される。 これ をもって 1 枚の ウェハ 1 4 の イ オン 住 人 は 終了 し た図面であって、10-6 Torr 程度の真空に保たれたイオン注入用のチャンパ26 には、ウェハ14の報送および設出のための真空ロック室がつ17 A・17 B そして18 A・18 B として2 質づつ設けられ、さらに不図示のウェハ鍛送機構が設けられている。

カエハ14ガチャンパ26内に入ると直ちにパ

税いてパルプ20Bを閉じて真空ロック室18A の真空引きを行い、所足の真空になったときパル プ20Aを開いて次のウェハがくるのを待つ。

本発明における各動作の所要時間を示したのがれる図であって、ウエハの取り付けと取り外しとは別のステーションで行っているため、従来のように近別になった長いT1(那8凶谷服)ではなく並列の短いT10でありこれはイオン注入時間T2ょり短い。従ってサイクルタイム~11はイオン住入時間に割り出し台20の割り出し回転時間である。

また其望ロック盆17A等におけるウエハの送人と収り出しは、ウエハ送人・真空引き・ウエハ収り出し・盤葉ガス導入の各動作があるためでの時間T12はかなり長くサイクルタイムT11より長いが、本発明では真空ロック盆は17A・17Bがよび18A・18Bと嵌入郷かよび収出の時間はT12の1/2 になる。即ちサイクルタイムT11よりは短くなる。

特開昭62-44571(4)

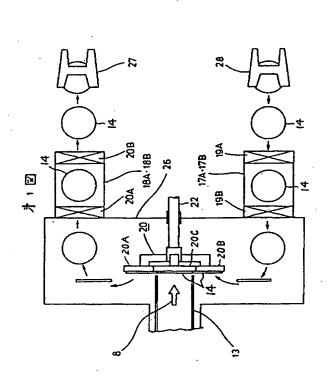
(発明の効果)

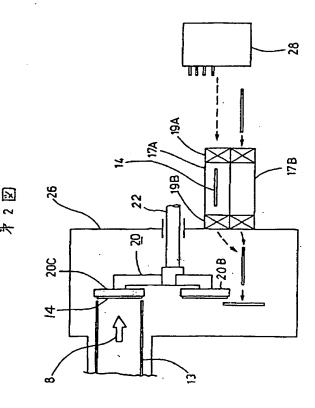
本発明のイオン注入装置は以上説明したように、カェハの取り付けと取り外しとを別のステーションで行りようにしたこと,ならびにチャンパに対するカエハの扱うが設出用として真空ロックをそれぞれ2類は出りに構成した。 この間も により割り出し回転をしている 間に大力に短縮され、かつ 観に大力に投稿され、かつ 選転中径とんどの時間がイオン在入に使用されているためイオンビームは有効に利用される。

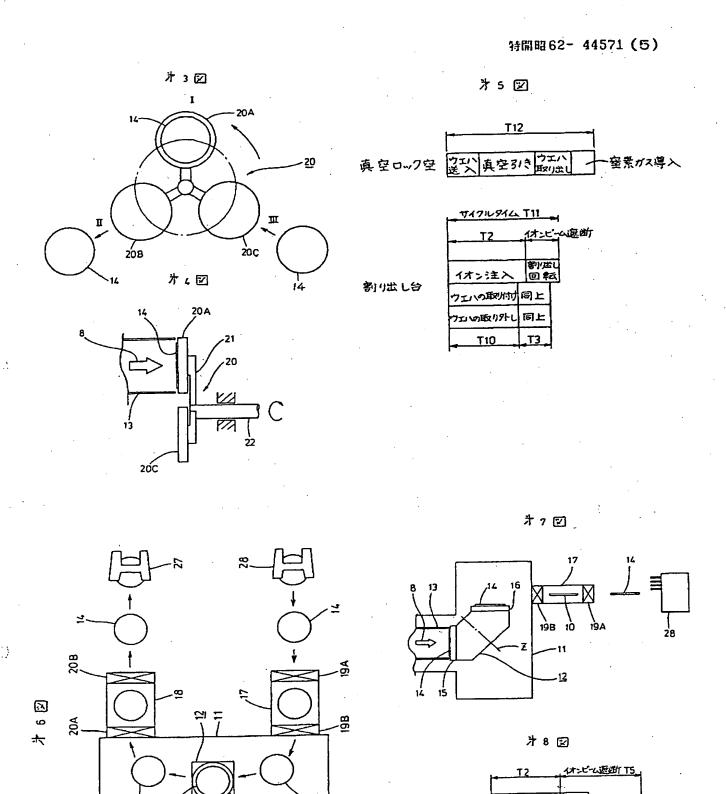
4. 図面の簡単な説明

第1四ないし部4図は本会明の一実施例を示し 第1回は平面図、第2回は側面図、第3回は割り 出し台の平面図、第4回は割り出し台とファラテ ーカップの側面図、第5回は本発明の割り出し台 に係る動作時間の説明図、第6回シェび第7回は 述来例を示し第6回は平面図、第7回は側面図、 第8回は従来例の割り出し台に係る動作時間と其 空ロック室の動作時間の説明図である。 13 … フアラデーカップ、17 A・17 B・ 18 A・18 B … 真空ロック室、20 … 割り出し 台、20 A・20 B・20 C … ブラテン、

出顧入 東芝機材株式会社







オン注入

ウエハの取が付けてエハの取り外し回転

71712914T4

割り出し台

手続補正書 (自発)

昭和60年10月28日

特許庁長官 字 賀 道 郎 殿

- 事件の表示
 昭和60年特許顯第182772号
- 2. 発明の名称 イオン注入装置
- 3. 補正をする者 特許出願人

〒104

住 所 東京都中央区鉄座4丁目2番11号名 称 (345)東芝梭城株式会社

代表者 飯 村 和 雄

4. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の機および 図面



5. 補正の内容

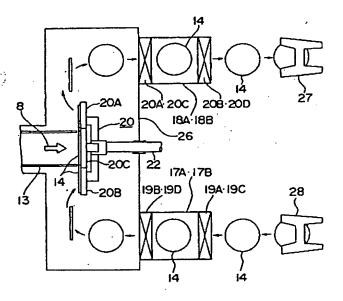
1) 明細書第8頁6行

「散けられている。」の後に次の字句を加入 する。

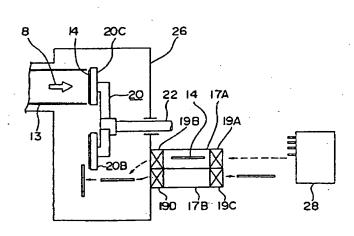
「なお、真空ロック室 17A・ 17B は、第 2 図に示すように、それらの入口と出口にそれぞれ設けたバルブ 19A・ 19C と 19B・ 19D によって開閉可能になされ、他方の真空ロック室 18A・ 18B もバルブ 20A・ 20C とパルブ 20B・ 20D により同様に開閉可能になっている。」

「割り出し台が……が可能になり、」を削除する。

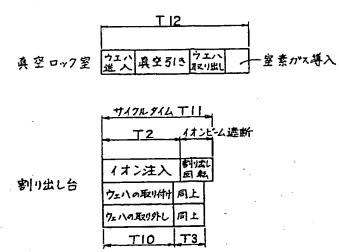




第2図



第5図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.